

國立交通大學 III-V氮化物材料與元件模擬研討會

III-V Nitride Material and Device Modeling Workshop

日期與時間: 102年11月20日 星期四 (8:50-17:10)

地點: 國立交通大學 新竹光復校區、交映樓一樓國際會議廳

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **<<議 程 表>>** | | | |
| 時間(Time) | 講 題(Topics) | 講 員(Speaker) | 主 持 人 |
| 08:30-8:50 | 報到 | | |
| 8:50-9:00 | Opening 長官致辭 | 謝漢萍 副校長  國立交通大學 | 郭浩中教授 |
| 9:00-9:40 | Research Frontiers in Semiconductor Device Simulation | Z. Simon Li 總裁  Crosslight Inc. | 郭浩中教授 |
| 9:40-10:20 | Current Status of GaN-on-Si Power Device Development at Epistar/HUGA | 洪詳竣 協理  晶元光電 | 郭浩中教授 |
| 10:20-10:40 | Coffee Break | | |
| 10:40-11:20 | Development and Applications of GaN-based Blue and UV LEDs | 李允立 創辦人  PlayNitride Inc. | 郭浩中教授 |
| 11:20-12:00 | GaN Power High Electron Mobility Transistor TCAD Simulation | Fred Yue Fu副總裁  Crosslight Inc. | 郭浩中教授 |
| 12:00-13:30 | 午餐 (Lunch Time) | | |
| 13:30-14:10 | Chip Scale Package (CSP) | 郭政達 協理  隆達電子 | 林建中教授 |
| 14:10-14:50 | Application of PVD AlN template for GaN-based LEDs | 郭政煌 教授  國立交通大學 光電學院 | 林建中教授 |
| 14:50-15:10 | Coffee Break | | |
| 15:10-15:50 | Introduction to GaN power electronics : SBDs, and D-mode, E-mode HEMTs | 黃建璋 教授  國立台灣大學 光電工程所 | 林建中教授 |
| 15:50-16:30 | Challenge and opportunity of MOCVD tool for LED and electronic devices | Akinori Ubukata 博士  Taiyo Nippon Sanso Corp. | 林建中教授 |
| 16:30-17:10 | GaN-based Vertical –Cavity Surface-Emitting Laser | 李宏道 總經理  Crosslight Inc. Taiwan branch | 林建中教授 |
| 17:10 | 散 會 | | |



III-V氮化物材料與元件模擬研討會報名表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱 | 國立交通大學 11/20 III-V氮化物材料與元件模擬研討會 | | | | |
| 姓名 |  | 公司或單位名稱 | | |  |
| E-MAIL |  | | | | |
| 連絡電話 |  | | | | |
| 是否須代購停車券? (NT. 30/張) |  | | 是否茹素? |  | |
| 備註欄 | * [請至以下網址報名](mailto:請點選以下網址報名或將此報名表email至marissa@crossligt.com.tw): https://docs.google.com/forms/d/1O3mLVclxa4Pg4ktyKikHT8kScwcJY8GVKm\_vKIDVKXM * 或是傳真至: (03)5752316 (麻煩傳真後打以下電話確認) 。 * 報名諮詢專線: (03)5752316 黃曼薇小姐。 * 報名表格，請填詳實，方便聯絡與寄送資料。 * 報名截止日期:11月18日。 | | | | |